

エレクトロニクス・表面技術フォーラム ～多品種少量デバイスの生産革命 ミニマルファブ～

- 【主催】 神奈川県産業技術センター
一般社団法人 表面技術協会 関東支部
- 【日時】 平成29年1月27日(金) 13:00～17:10
- 【定員】 60名
- 【参加費】 無料
- 【会場】 神奈川県産業技術センター (海老名市下今泉705-1)
管理・情報棟 2階 カンファレンスルーム

神奈川県産業技術センターでは産学公の研究者、技術者等の交流と技術移転等を積極的に推進するため、技術交流フォーラムを開催しております。

今回は、「エレクトロニクス・表面技術フォーラム ～多品種少量デバイスの生産革命 ミニマルファブ～」と題した技術フォーラムを(一社)表面技術協会関東支部との合同講演会として開催する運びになりました。

ミニマルファブとは、1/2インチ(約1.3cm)サイズの小口径ウェハを製造基板単位とする半導体生産システムです。これまでに「国立研究開発法人 産業技術総合研究所コンソーシアム・ファブシステム研究会」を中心に産学公連携により研究開発を進めており、既に平成26年度には簡易デバイス(MEMS、ダイオード、MOS、CMOSなど)が試作出来るレベルの成果が出ています。

本フォーラムでは、(国研)産業技術総合研究所ファブシステム研究会の原 史朗 代表を始め、研究開発に携わっている研究員の方々から開発状況の御紹介を頂きます。さらに、ミニマルファブを用いて実際のデバイス開発等を行っている企業の方々から、活用事例等の御紹介を頂きます。

皆様の積極的な御参加をお待ちしております。

<プログラム>

- 挨拶 (13:00～13:10)
- ミニマルファブの概要 (13:10～14:10)
「多品種少量デバイスの生産革命 ミニマルファブ」 (国研) 産業技術総合研究所 原 史朗
- ミニマルファブの開発状況 (14:10～15:55)
「3日でできるCMOS試作」 (国研) 産業技術総合研究所 クンプアン ソマワシ
「既存装置とミニマル装置のハイブリッド方式によるSOI-MOSFET試作と評価」 (国研) 産業技術総合研究所 柳 永助
「ミニマルだから初めてできた高品位垂直エッチング技術」 (国研) 産業技術総合研究所 田中 宏幸
「前工程と統一されたミニマルパッケージング技術開発」 (国研) 産業技術総合研究所 居村 史人
- ミニマルファブの活用事例 (15:55～16:55)
「世界初1個からの再配線ファウンドリサービス」 (株) ピーエムティー 三宅 賢治
「ミニマルファブ トータル・ソリューション事業」 横河ソリューションサービス(株) 永井 亨
「ネイタスの進めるミニマルファウンドリ事業(仮題)」(株) ネイタス 吉田 政孝
- 全体討論 (16:55～17:10)

申込 方法

裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXによりお申込みください。

申込先: **FAX 046-236-1525**

※神奈川県産業技術センターのホームページからも申し込みできます。

申込受付締切: 1月20日(金)

(定員に達していない場合は、当日参加も可能です。お気軽にお問い合わせください。)

問い合わせ先 神奈川県産業技術センター 電子技術部 電子材料チーム 小沢、安井
電話 046-236-1500(代表) (内 3315)

